



Intyg Certificate





Härmed intygas att bifogade kopior överensstämmer med de handlingar som ursprungligen ingivits till Patent- och registreringsverket i nedannämnda ansökan.

This is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally filed with the Patent- and Registration Office in connection with the following patent application.

- (71) Sökande Obducat AB, Malmö SE Applicant (s)
- (21) Patentansökningsnummer 0201917-2 Patent application number
- (86) Ingivningsdatum
  Date of filing

2002-06-20

Stockholm, 2003-06-23

För Patent- och registreringsverket For the Patent- and Registration Office

Sonia André

Avgift Fee

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

10

30

#### AWAPATENT AB

OBDUCAT AKTIEBOLAG

Ansökningsnr

Vår referens SE-2013226

Kontor/Handläggare Växjö/Erik Simonsson/ESN

1

t Fatent-or

Ē

# FORMVERKTYG SAMT SÄTT ATT FRAMSTÄLLA DETTA

Hower'...

30.27 · 1

#### Tekniskt område

Föreliggande uppfinning avser ett sätt att framställa ett formverktyg, som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål och har ett skikt, som är antividhäftande med avseende på föremålet.

Uppfinningen avser även ett formverktyg, som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål och har ett skikt, som är antividhäftande med avseende på föremålet.

Föreliggande uppfinning avser även ett lagringsmedium, såsom en CD- eller DVD-skiva eller en hårddisk.

## Teknisk bakgrund

Vid replikering av nanostrukturer används ofta en stamp, som präglar ett mönster i en med en lämplig polymer, såsom en termoplast, belagd platta. Det är nödvändigt att åstadkomma en antividhäftande gränsyta mellan den mönstrade stampen och polymeren för att undvika att polymeren fastnar på och kontaminerar stampens yta då stampen efter prägling lösgörs från den belagda plattan. Även det replikerade mönstret på plattan kan skadas av en sådan vidhäftning. En framgångsrik prägling kräver sålunda att stampen är kemiskt och mekaniskt stabil och har ringa vidhäftning vid polymerer.

R.W. Jaszewski et al beskriver i Microelectronic Engineering 35 (1997) 381-384 att stampens yta kan täckas med ett ultratunt, antividhäftande skikt av PTFE (polytetrafluoreten). Skiktet fälls ut med hjälp av antingen plasmapolymerisation eller jonsputtring från ett plasma. Jaszewski et al uppger att skiktets kvalitet försämras då stampen utnyttjas för upprepade präglingar. Skiktet är uppenbarligen inte tillräckligt stabilt.

10

15

20

25

30

35

2

Ę

· ....

~- <u>2</u>

10162

1::

I WO 01/53889 beskrivs ett sätt att fästa ett monomolekylärt, antividhäftande skikt på en metallstamp. Detta sätt förutsätter att det monomolekylära skiktet innefattar en merkaptogrupp som kan binda in till metallstampen och bilda en metallsulfid.

Det ovan nämnda monomolekylära skiktet är dock specifikt anpassat till en viss yta och kräver att det monomolekylära skiktet innefattar en merkaptogrupp som kan binda in till metallstampen och bilda en metallsulfid. I vissa applikationer har det monomolekylära skiktet inte heller tillräckligt bra vidhäftning vid stampens respektive formens yta. Detta kan dels innebära att det monomolekylära skiktet lossnar från stampen, varvid stampen måste kasseras eller repareras, dels att ett föremål, såsom en DVD-skiva, till vilket ett mönster skall överföras, skadas vid överföringen av mönstret på grund av vidhäftning vid stampen.

### Sammanfattning av uppfinningen

Ändamålet med föreliggande uppfinning år att undanröja eller minska de ovannämnda nackdelarna och åstadkomma ett sätt att framställa ett formverktyg, som har ett antividhäftningsskikt, som är stabilt och har goda antividhäftande egenskaper. Ändamålet uppnås enligt uppfinningen med ett sätt att framställa ett formverktyg, som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål och har ett skikt, som är antividhäftande med avseende på föremålet, vilket sätt kännetecknas av stegen

att ett stampāmne förses med reliefmönster på en yta,

att den mönstrade ytan beläggs med ett skikt av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda en mekaniskt stabil oxidfilm,

att skiktet av metall oxideras för bildande av en oxidfilm, och

+46 470 20867

Ink t. Patrol- osb regno podry 1995 - 200 Obrasif - en Poran

3

att oxidfilmen påförs åtminstone ett reagens, som innehåller molekylkedjor, som var och en har en kopplingsgrupp, som binds med kemisk bindning, företrådesvis en kovalent bindning, till oxidfilmen, varvid molekylkedjorna antingen från början innefattar åtminstone en fluorinnehållande grupp eller i en efterföljande behandling förses med åtminstone en sådan grupp.

Ett ytterligare ändamål med föreliggande uppfinning är att åstadkomma ett formverktyg, som har ett 10 antividhäftningsskikt, som är stabilt och har goda antividhäftande egenskaper. Detta ändamål åstadkommes med ett formverktyg, som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål och har ett skikt, som är antividhäftande med avseende på föremålet, 15 vilket formverktyg kännetecknas av att formverktyget innefattar ett stampämme, som på sin yta uppvisar ett reliefmönster, och ett skikt av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda en mekaniskt stabil oxidfilm, vilket skikt av metall har applicerats på 20 nämnda yta och sedan oxiderats för bildande av en mekaniskt stabil oxidfilm, varvid det antividhäftande skiktet innefattar molekylkedjor, som vardera har atminstone en kopplingsgrupp, som med kemisk bindning, företrädesvis en kovalent bindning, är bunden till 25 oxidfilmen, och åtminstone en fluorinnehållande grupp.

Ett ytterligare ändamål med uppfinningen är att åstadkomma ett lagringsmedium, såsom ett optiskt lagringsmedium, såsom en CD- eller DVD-skiva eller en skiva som har ännu finare strukturer, eller ett magnetiskt lagringsmedia, såsom en hårddisk, vilket medium har ett reliefmönster som inte skadats på grund av vidhäftning vid ett formverktyg då reliefmönstret framställdes, varvid mediet har hög kvalitet. Detta åndamål uppnås enligt uppfinningen med ett lagringsmedium, såsom en CD- eller DVD-skiva eller en hårddisk,

10

30

35

+46 470 20867

The first of the second

. - Z A

age of a lan Kotse

4

vilket kännetecknas av att ett formverktyg enligt ovan utnyttjats för utformning av ett reliefmönster på mediet.

Ytterligare fördelar och kännetecken hos uppfinningen framgår av nedanstående beskrivning och de efterföljande patentkraven.

## Kortfattad beskrivning av ritningarna

Uppfinningen kommer nu att beskrivas mera i detalj med hjälp av ett icke begränsande utföringsexempel och under hänvisning till bifogade ritningar.

Fig 1 år en tvärsektion och visar ett parti av en med ett metallskikt försedd stamp av nickel avsedd för prägling av DVD-skivor.

Fig 2 är en förstoring av det i fig 1 visade partiet 15 II och visar metallskiktet med ett därpå fäst antividhåftande skikt.

# Detaljerad beskrivning av uppfinningen

ster i nanoskala är nanopräglingslitografi (även kallat nanoimprintlitografi), som är en teknik för massproduktion av nanostrukturer. Ett formverktyg i form av en stamp förses med ett nanomönster på sin yta. Stampen värms och pressas mot ett med ett polymerskikt belagt substrat, varvid mönstret överförs till polymerskiktet. Nanoprägling beskrivs närmare i WO 01/69317 och US 5 772 905. Stampen enligt föreliggande uppfinning kan även användas i andra präglingsprocesser samt med eller utan värmning före pressningen.

Ett annat exempel på överföring av mönster i nanoskala är framställning av CD- och DVD-skivor. Förfarande för framställning av CD-skivor beskrivs exempelvis i "The compact disc handbook" av C Pohlmann, Second edition, A-R Editions Inc, ISBN 0-89579-300-8, s 277 ff. Vid denna framställning utnyttjas en gjutform i vilken en skiva av polykarbonat gjuts. Ett formverktyg i form av en mönstrad

15

20

25

30

35

5

nickelstamp införs i en vägg i gjutformen för utformning av ett önskat mönster på CD- eller DVD-skivan.

Termen "nanoskala" skall inte tolkas som att den endast avser strukturer i submikrometerområdet, dvs strukturer med en storlek i området 1-1000 nm. En stamp har ofta ett mönster med både strukturer i submikrometerområdet och strukturer med en storlek av upp till 100 mikrometer och större, såsom upp till omkring 5 mm. Föreliggande uppfinning är företrädesvis användbar för stampar som innefattar strukturer i submikrometerområdet och/eller området 1-100 mikrometer. Den bästa effekten av uppfinningen uppnås med strukturerna i submikrometerområdet eftersom dessa relativt sett är kånsligare för vidhäftning då stampen lösgörs.

Termen "monomolekylärt skikt" avser i föreliggande ansökan ett skikt med en tjocklek som motsvarar längden hos en molekyl. Den molekyl som vid föreliggande uppfinning ingår i det monomolekylära skiktet är långsträckt och är vid sin ena ände kemiskt bunden till en yta. De till ytan bundna molekylerna har ingen eller endast ringa tendens att vidhäfta, kemiskt eller fysiskt, till andra molekyler eller andra ytor.

Enligt föreliggande uppfinning åstadkommes en stamp för användning vid utformning av mönster i nanoskala, vilken stamp har ett mycket stabilt och slitstarkt antividhäftande skikt. "Utformning av mönster" kan, såsom det används i föreliggande ansökan, innebära att stampen utnyttjas för att prägla in ett mönster i ett föremål, eller att stampen utnyttjas som en vågg i en form i vilken ett föremål, som skall erhålla mönstret, gjuts.

I ett första steg utnyttjas ett stampämme vars yta reliefmönstras på något tidigare känt sätt, exempelvis genom etsning eller gjutning i en mönstrad gjutform. Lämpliga material i stampämmet är exempelvis nickel, krom, kisel, kiseldioxid, kiselkarbid, wolframoxid, diamant, olika polymerer, halvledarmaterial, såsom GaAs,

25

30

\* ~- Z

· ' un l'oc

б

InP, GaInP, GaInAs, ZnS, samt blandningar av dessa material. Speciellt föredragna material för framställning av en stamp är kisel och nickel, eftersom dessa material är lätta att mönstra och har hög hårdhet och slitstyrka. Stampämnet kan även innefatta ett skikt av nickel som applicerats på en basplatta av kisel.

Efter mönstringen tvättas stampämnets mönstrade yta, lämpligen med ett eller flera organiska lösningsmedel, och torkas.

10 Efter tvätten appliceras ett tunt metallskikt på stampämnets mönstrade yta. Metallskiktet kan lämpligen appliceras med hjälp av från andra teknikområden tidigare kända metoder för applicering av tunna metallskikt på ytor. Olika metoder för utfällning av metallskikt

beskrivs i bland annat "Handbook of deposition technologies for films and coatings: Science, technology and applications", edited by Rointan F. Bunshah, second ed., Noyes Publications, Westwood, NJ, USA 1994, ISBN 0-8155-1337-2. De föredragna metoderna vid föreliggande

uppfinning är beläggning med förångad metall i vakuum, vilket beskrivs i kapitel 4 i ovannämnda handbok, och sputtring, vilket beskrivs i kapitel 5 i ovannämnda handbok. Metallskiktets tjocklek kan måtas med hjälp av i kapitel 4 resp 5 i ovannämnda handbok beskrivna metoder.

Vid beläggning med förångad metall i vakuum placeras det mönstrade stampämnet lämpligen på en roterande platta i en ugn som evakueras till ett tryck av exempelvis 1-100 mPa. Stampämnet har lämpligen en temperatur, som ligger nära rumstemperatur. Förångad metall tillförs sedan ugnen och kondenserar på stampämnets yta i ett tunt skikt. Roterandet av stampämnet under beläggningen medför att skiktet blir väsentligen lika tjockt på alla partier av stampämnets mönster. Metallskiktets tjocklek mäts under beläggningen med hjälp av en kalibrerad, i ugnen

placerad, vibrerande kristall. Ett metallskikt kommer att beläggas även på kristallen, som då får en förändrad

10

15

20

25

30

35

Proceedings Kess

7

frekvens. Förändringen i frekvens utnyttjas som ett mått på metallskiktets tjocklek.

Vid beläggning med ett metallskikt med hjälp av sputtring, exempelvis magnetronsputtring, placeras stampämnet och ett fast stycke av den metall som skall bilda skiktet i en kammare som innehåller en ädelgas, såsom Argon, och har mycket lågt tryck, såsom 1-100 mPa. Ädelgasen joniseras och en magnetron sänder ädelgasjonerna, i förekommande fall argonjonerna, mot metallstycket. Argonjonerna slår ut ytatomer från metallstycket, vilka sedan fälls ut på stampämnets yta. Då ett tillräckligt tjockt metallskikt fällts ut på stampämnets yta avslutas beläggningen och den därmed bildade stampen tas ut ur ugnen resp kammaren.

Metallskiktet skall därefter oxideras. Beroende av den aktuella metallen kan oxidationen antingen ske spontant eller åstadkommas genom lämplig behandling. Spontan oxidation kan ske vid kontakt med omgivningsluft, filtrerad omgivningsluft, ren syrgas eller en blandning av syrgas och kvävgas. En lämplig behandling kan bestå i att metallen behandlas med ett syrgasplasma eller anodiskt. Behandling av en metallyta med ett syrgasplasma beskrivs i exempelvis den ovan nämnda "Handbook of deposition technologies...", kapitel "Surface preparation for film and coating deposition processes", sid 82-130, särskilt sid 108-120.

Den metall som ingår i metallskiktet skall vara sådan att den vid oxidering bildar kemiskt och mekaniskt stabila oxider till vilka ett antividhäftningsskikt kan bindas. Med "kemiskt stabil" avses här att den oxiderade metallens oxidationstal inte skall förändras vid de tryck, temperaturer och kemiska förhållanden som råder dels vid framställning av det antividhäftande skiktet, dels vid användning av stampen vid nanoimprintlitografi eller gjutning. Med "mekaniskt stabil" avses här att den oxiderade metallen inte skall lossna från stampämnet eller på annat sätt ändra form vid de tryck och

+46 470 20867

The Constraint of the Constrai

Part of the sea

8

temperaturer som råder dels vid framställning av det antividhäftande skiktet, dels vid användning av stampen vid nanoimprintlitografi eller gjutning.

Metallen bör ha ett stabilt oxidationstal. Metaller med ett föredraget oxidationstal bildar huvudsakligen endast en typ av oxid med ett kemiskt stabilt oxidationstal, som inte ändras under framställning av det antividhäftande skiktet eller vid användning av stampen för nanoimprintlitografi eller gjutning av relief-

mönstrade föremål. Vissa metaller kan ha en katalytisk effekt som synes ha en oxiderande effekt på kolkedjor i det antividhäftande skiktet vid de förhållanden som råder under ovan nämnda användning. Exempel på metaller med sannolik katalytisk effekt är platina, Pa, och palladium,

Pd, men i viss mån även andra metaller som nickel, Ni. En indikation på detta anges i "Preparation of novel Raney-Ni catalysts and characterization by XRD, SEM and XPS", Hao Lei et al, Applied Catalysis A: General 214 (2001) 69-76. Raney-nickel är ett svampformigt nickelämne som

har katalytisk effekt och bland annat kan bryta ned kolväten. En nanostrukturerad nickelyta kan anses ha vissa likheter med Raney-nickel och kan därför ha nedbrytande effekt på ett monomolekylärt skikt. Risken är därför stor att ett monomolekylärt skikt som är fäst på

25 t ex en stamp med en nickelyta lossnar från nickelytan.
Då ett stampämne är framstållt av flera olika material,
tex ett stampämne som är framstållt av en metallegering
eller ett stampämne framstållt av flera delar av olika
material, kommer metallskiktet att åstadkomma att

30 ytskiktet får samma och dessutom förutsägbara egenskaper över hela stampens yta.

En annan viktig egenskap hos metallskiktet är att det skall ha god vidhäftning vid det aktuella materialet i stampämnet.

Den bildade oxiden bör ha god mekanisk hållfasthet så att den tål upprepade ståmplingar med stampen. Än mer föredraget är att oxiden är så hård att ett hårt ytskikt

-::

bildas, vilket är slitage- och trycktåligt. Hårdheten på oxidskiktet är lämpligen åtminstone 4 enligt Mohs skala, än mer föredraget åtminstone 5.

Metaller som är speciellt lämpliga för beläggning av stampāmnets yta ār titan, Ti, zirkonium, Zr, niob, Nb, 5 tantal, Ta och aluminium, Al. Det monomolekylära skiktet synes ha bäst vidhäftning vid metallskiktet om bindningen mellan molekylerna och metallskiktet har en övervägande kovalent struktur. B.F. Levine har i Phys. Rev B 7, 2591, (1973) gjort mätningar av Phillips-jonicitet. Enligt 10 dessa mätningar är joniciteten för NiO 0,841, för Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,796 och för TiO2 0,686. En möjlig tolkning av dessa resultat är att  $TiO_2$  har minst jonisk karaktär och därmed skulle kunna ge upphov till bindningar med mer kovalent karaktār an NiO. Även detta skulle sāledes kunna vara en 15 förklaring till att en nickelyta inte är helt lämplig för att kvarhålla ett monomolekylärt skikt.

Titan bildar vid kontakt med omgivningsluft stabil titandioxid, som kan föreligga i form av TiO2 och/eller TiO(OH)2 i olika inbördes förhållanden beroende på 20 luftfuktighet, temperatur mm. Då skiktet av titan har torkats, såsom är fallet vid nedan beskrivna inbindning av ett antividhäftningsskikt, föreligger titandioxiden nästan enbart som TiO2. Efter en kort tids kontakt med omgivningsluft föreligger titan i ytskiktet nästan enbart 25 som fyrvärt titan, Ti+IV, och bildar således en stabil oxid, som är våsentligen kovalent avseende bindningskaraktären. Zirkonium, Zr., bildar på liknade vis stabil zirkoniumoxid, som kan representeras av ZrO2, i vilken zirkonium har det helt övervägande oxidationstalet 30 +IV. Niob, Nb, bildar vid kontakt med omgivningsluft stabil Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Tantal, Ta, bildar vid kontakt med omgivningsluft stabil Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Tantal resp niob har i dessa oxider oxidationstalet +V. Aluminium bildar vid kontakt med omgivningsluft stabil aluminiumoxid, som antages 35 föreligga i form av Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, där aluminium är trevärt, Al+III. Metallen bör bilda kovalenta oxider eftersom

15

20

25

35

+46 470 20867

10

detta ofta innebär en högre hårdhet hos oxidskiktet än vid joniska oxider. Titan och aluminium är därmed särskilt lämpliga metaller.

I vissa fall är det för åstadkommande av bästa möjliga vidhäftning lämpligt att genom en behandling i reducerande miljö avlägsna eventuell oxid från stampämnets yta innan metallskiktet appliceras på denna yta. Det förefaller dock som att vissa metaller, exempelvis titan och aluminium, kan uppta syre från ett stampämnes oxid och bilda ett metallskikt som har god vidhäftning vid stampämnets yta även om stampämnets yta inte är oxidfri då metallskiktet appliceras.

Metallskiktet bör ha sådan tjocklek att ett homogent och stabilt oxidskikt bildas på metallskiktets yta samtidigt som metallskiktet är stabilt fäst vid det underliggande stampämnet. Ett alltför tjockt metallskikt kan påverka stampämnets mönster så att önskat resultat ej erhålles vid prägling med den färdiga stampen. Det år dock ofta möjligt att vid utformning av stampämnets yta ta hänsyn till att ett metallskikt av viss tjocklek skall fällas ut på stampämnet och anpassa stampämnets strukturer efter detta. En annan orsak till att metallskiktet inte bör vara för tjockt är att sprickor kan uppstå i metallskiktet vid uppvärmning av stampen om stampämnet och metallskiktet har olika värmeutvidgningskoefficient. Eftersom stampen värms upp under nanopräglingen respektive gjutningen skulle ett tjockt metallskikt och en skillnad i värmeutvidngingskoefficient med åtföljande sprickbildning påverka stampens livslängd negativt.

30 Metallskiktet har lämpligen en tjocklek av 1-300 nm, än mer föredraget 1-100 nm och mest föredraget 2-20 nm.

Vid vissa stampämnen är det lämpligast att metallskiktet har sådan tjocklek att det i gränsskiktet mot stampämnets yta även efter oxidering föreligger i metallisk form för att ge god vidhäftning vid nämnda stampämne. Om metallskiktet år alltför tunt kan syreatomer vandra igenom metallskiktet ned till

10

15

20

25

30

35

+46 470 20867

11

stampämnet och oxidera detta, vilket i vissa fall är negativt för vidhäftningen av metallskiktet mot stampämnets yta. Vid exempelvis titandioxid har det visat sig att titandioxidskiktet efter oxidering i omgivningsluft enligt ovan erhåller en tjocklek av ca 5 nm. Då metallskiktet är ett titanskikt är det ofta lämpligt att titanskiktet har en tjocklek av mer än 5 nm, lämpligen ca 10 nm. Ett genom oxidation i omgivningsluft bildat skikt av aluminiumoxid har en tjocklek av åtminstone ca 2 nm. Ett skikt av aluminiumoxid har därför

lämpligen en total tjocklek av åtminstone ca 5 nm.

I andra fall, såsom då ett skikt av titan eller aluminium appliceras på ett stampämne av nickel, kommer även oxiden, titandioxid eller aluminiumoxid i nämnda fall, att ha tillräcklig vidhäftning mot stampämnet. Vid titanskikt på ett nickelstampämne bestäms således den minsta tjockleken på titanskiktet av den tjocklek som krävs för att det bildade titandioxidskiktet skall vara tillräckligt hållfast och täcka hela stampämnets yta. Vid ett stampämne av nickel bör skiktet av titan eller aluminium ha en tjocklek av åtminstone ca 2 nm.

Ett antividhäftningsskikt fästs sedan på det oxiderade metallskiktet. Enligt en föredragen utföringsform av uppfinningen används ett första och ett andra reagens. Det första reagenset binds vid en första reaktion till metallskiktet, varvid det andra reagenset vid en andra reaktion binds till det första reagenset. Anledningen till att denna utföringsform ofta är föredragen är att det är relativt enkelt att få tag på kommersiellt tillgängliga föreningar som är lämpliga att använda som första respektive andra reagens.

Ett första reagens för användning vid framställning av stampen enligt uppfinningen har åtminstone två funktionella grupper. En första funktionell grupp är avsedd att binda in till metallskiktets yta. Ett exempel på en sådan första funktionell grupp är en silangrupp med formeln  $(B0)_{3-n}R'_nSi-$ . Silangruppen kan bindas till

12

metallskiktetmedelst en grupp B1 på metallskiktets yta, varvid B1 vanligen är M-O- eller M-OH där M är en i metallskiktet ingående metallatom. "Silangrupp" avser i föreliggande ansökan även ovannämnda grupp efter det att den bundits till stampen. Silangruppen kan innefatta n alifatiska grupper R' och 3-n reaktiva bindningsgrupper B0, där n=0, 1 eller 2. B0 är lämpligen en hydrolyserbar grupp. Lämpliga reaktiva bindningsgrupper B0 är klor (C1) eller alkoxigrupper, företrädesvis C<sub>1-4</sub> alkoxigrupper, mera föredraget C1-2 alkoxigrupper, såsom etoxigrupper 10 (EtO), metoxigrupper (MeO). De alifatiska grupperna R' är lämpligen, i den mån de alls är närvarande, korta, mättade alifatiska grupper, företrädesvis  $C_{1-4}$  alkylgrupper, mera föredraget C1-2 alkylgrupper såsom etylgrupper och metylgrupper. Då n=1 eller 2 och R' är en 15 metylgrupp erhålls en mindre bindningsyta, dvs det monomolekylära skiktet kan packas tätare. Den starkaste bindningen till ytan erhålles dock då n=0, dvs då silangruppen har tre reaktiva bindningsgrupper B0. Ett exempel på en lämplig första funktionell grupp är således: 20

Eto - Si-

[första funktionell grupp i form av trietoxisilan]

25

30

35

Ett annat exempel på en lämplig första funktionell grupp är en fosfatgrupp, -H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>.

Det första reagenset har en andra funktionell grupp X1, som lämpligen väljs så att den ej reagerar eller endast i begränsad omfattning reagerar med metallskiktets yta. En sådan funktionell grupp har den fördelen att ett homogent monomolekylärt skikt med en väldefinierad ändgrupp erhålles då metallskiktets yta behandlas med det första reagenset. Gruppen X1 är således lämpligen en icke hydrolyserbar grupp. Gruppen X1 bör ej heller reagera med den första funktionella gruppen. Lämpliga grupper X1 är exempelvis -SH, -NH2, och -OH. Då X1 är en -NH2 grupp

30

Ø

. :: ::

eller en -OH grupp får BO ej vara klor, eftersom detta skulle medföra oönskade polymeriseringsreaktioner.

Det första reagensets första och andra funktionella grupper är lämpligen fästa i två motstående ändar av en kolförening R1. Företrädesvis år en sådan kolförening R1 en kolkedja, som är ogrenad eller har korta grenar, som lämpligen har en långd av 1-6 kolatomer, mer föredraget 1-3 kolatomer. Kolkedjan år lämpligen en mättad, alifatisk kolkedja. Omättade kolkedjor kan delta i oönskade bireaktioner och starkt grenade eller cykliska föreningar tar onödigt stor plats på stampens yta, vilket minskar densiteten av antividhäftningsfunktionalitet på denna yta.

Den andra funktionella gruppen X1 kan påverka elektrontätheten i de närmast belägna atomerna i molekylen, vilket kan ge oönskade effekter på den första funktionella gruppen. Det är därför lämpligt att R1 gruppen har sådan utformning att den ur elektrontäthetssynpunkt "isolerar" gruppen X1 från den första funk-20 tionella gruppen. Vid alifatiska, mättade kolkedjor är den CH2-grupp som sitter närmast X1 starkt påverkad, den nästkommande CH2-gruppen något påverkad, medan den tredje CH2-gruppen är väsentligen opåverkad av X1. Gruppen R1 är lämpligen osubstituerad för att inte påverka de första 25 och andra funktionella grupperna negativt. R1 har således lämpligen en längd från den första till den andra funktionella gruppen av 1-10 kolatomer, företrädesvis 2-5 kolatomer och mest föredraget 3 kolatomer.

Det är lämpligt att välja ett första reagens som uppfyller ovan beskrivna kriterier och som är kommersiellt tillgängligt. Exempel på ett föredraget första reagens är således merkaptopropyltrietoxisilan:

10

15

20

25

30

35

14

Det andra reagenset innefattar en första del X2, som är avsedd att bindas till det första reagensets X1-grupp, och en andra del R2, som har antividhäftningsfunktionalitet.

Gruppen X2 väljs så att den är lämplig för reaktion med den X1-grupp som föreligger i det första reagenset. Reaktionen skall resultera i en bindning som år tillräckligt stark för att hålla kvar antividhäftningsfunktionaliteten vid stampens yta. Den bindning som bildas mellan X1 och X2 år dock svagare än övriga bindningar i det monomolekylära skiktet. Ett eventuellt brott på molekylkedjan kommer då att ske på ett förutsägbart ställe, nämligen mellan X1 och X2. Exempel på lämpliga kombinationer av X1 och X2 är: X1 = -SH grupp och X2 = -SH grupp, vilka kan bilda en svavelbrygga, X1 = -NH2 grupp och X2 = Cl-(C=O)-, vilka kan bilda en peptidbindning, samt X1= -OH och X2= HO-(C=O)-, vilka kan bilda en ester. Speciellt föredraget är att såväl X1 som X2 är -SH grupper, eftersom dessa bildar en bindning som är stark nog för att hålla kvar antividhäftningsfunktionaliteten, men är svagare än exempelvis bindningar mellan kolatomer i molekylkedjan, mellan kolatomer och svavelatomer och mellan en silangrupp och stampens yta.

Gruppen R2 innehåller lämpligen fluoratomer, vilka ger den önskade antividhäftningsfunktionaliteten. Speciellt lämpligt är att R2 har en fri ändgrupp, som innehåller en kolatom till vilken en eller flera fluoratomer är bundna. Företrädesvis är gruppen R2 en fluorerad, alifatisk, måttad kolkedja. Omåttade kolkedjor kan delta i oönskade bireaktioner och starkt grenade eller cykliska föreningar tar onödigt stor plats, vilket minskar densiteten av antividhäftningsfunktionalitet.

Fluoratomerna kommer att påverka elektrontätheten i de närmast belägna atomerna i molekylen, vilket kan ge oönskade effekter på bindningen mellan X2 och X1. Det är därför lämpligt att gruppen R2 har sådan utformning att den ur elektrontäthetssynpunkt "isolerar" X2 gruppen från

.

: :

11.1.

15

fluoratomerna. Vid alifatiska, mättade kolkedjor är den CH<sub>2</sub>-grupp som sitter närmast en kolatom, som är substituerad med fluor, starkt påverkad, medan den nästkommande CH<sub>2</sub>-gruppen är nästan opåverkad. Gruppen R2 har lämpligen åtminstone 1 och företrädesvis 2 CH<sub>2</sub>-grupper i rad närmast gruppen X2. Vid längre kedjor av CH<sub>2</sub>-grupper ökar risken för brott. Antalet CH<sub>2</sub>-grupper i rad bör således inte vara mer än 5.

R2 har lämpligen åtminstone en perfluorerad kolatom. Företrädesvis är denna kolatom R2-gruppens ändgrupp, dvs en CF3-grupp. Fler perfluorerade kolatomer ger bättre antividhäftningsfunktionalitet. Mycket långa kolkedjor ökar risken för brott på kedjan och gör också antividhäftningsskiktet mindre stabilt, då kolkedjorna kan ändra vinkel i förhållande till ytan. R2 har således lämpligen 1-12 perfluorerade kolatomer, företrädesvis 2-8 perfluorerade kolatomer och mest föredraget 3-6 perfluorerade kolatomer.

Det är lämpligt att välja ett andra reagens som uppfyller ovan beskrivna kriterier och som är kommersiellt tillgängligt. Exempel på föredragna andra reagens är således 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooktantiol:

## SH-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-(CF<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-CF<sub>3</sub>

25

30

35

20

10

15

Det oxiderade metallskiktet tvåttas med hjälp av exempelvis 1-4 organiska lösningsmedel, exempelvis trikloretylen, etanol, aceton och isopropanol, efter varandra. Stampen behandlas sedan med det första reagenset. Denna första behandling kan utföras antingen i våtskefas eller i gasfas.

Vid en första behandling i vätskefas placeras stampen under ca 1-5 h i ett kärl, som innehåller ca 0,1-1% av det första reagenset i ett organiskt lösningsmedel, lämpligen en vattenfri alkan, vid rumstemperatur. Stampen tvättas sedan lämpligen med hjälp av en serie av 1-4 organiska lösningsmedel liknande de ovan nämnda för

15

20

30

35

att ta bort sådana föreningar som ej bundits kovalent till ytan.

Vid en första behandling i gasfas placeras stampen i en ugn med vattenfri kvävgasatmosfär vid en temperatur av ca 50-250°C, lämpligen ca 150-220°C, och ett tryck vid vilket det första reagenset befinner sig i gasfas, vanligen ett tryck av ca 0,5-20 kPa, lämpligen ca 1-3 kPa. Den exakta kombinationen av temperatur och tryck väljs på sådant sätt att det aktuella första reagenset med säkerhet föreligger i gasfas. Det första reagenset förs sedan in i ugnen, exempelvis med hjälp av en spruta, förångas och får reagera med stampen under ca 0,5-10 h. Stampen tas sedan ut ur ugnen och får svalna varefter den tvättas med en serie av organiska lösningsmedel enligt ovan.

Gasfasreaktionen är betydligt mer komplicerad att utföra än den förhållandevis enkla vätskefasreaktionen. Gasfasreaktionen ger dock ofta ett betydligt homogenare monolager på stampens yta och är därför att föredra i många fall.

Vid ett stampämne med ett metallskikt av titan och ovannämnda föredragna första reagens kan således följande resultat erhållas efter den första behandlingen:

I beroende av ytans ursprungsstruktur kan bindningens mellan metallytan och silangruppen faktiska struktur och restprodukten, etan eller etanol i exemplet ovan, påverkas något. Bindningen mellan titanytan och silangruppen antas kunna ha utseendet (Ti)<sub>3</sub>Si eller (Ti-O)<sub>3</sub>Si, men det exakta utseendet är inte helt klarlagt. Ovannämnda formler avses därmed beteckna en silangrupp som bundits till en metallyta oberoende av den faktiska bindningens exakta utseende.

10

15

20

25

30

35

Den tvättade stampen behandlas sedan med det andra reagenset. Denna andra behandling kan utföras i såväl vätskefas som gasfas.

Vid en andra behandling i våtskefas placeras stampen i ett kärl som innehåller ett lämpligt lösningsmedel, exempelvis en vattenfri alkan, med ca 0,1-5% av det andra reagenset vid rumstemperatur. Reaktionen får fortgå under ca 6-24 h varefter stampen tas upp och rengörs genom doppning i ett eller flera bad med ett lämpligt, organiskt lösningsmedel, exempelvis ovannämnda alkan. Stampen torkas sedan och är därefter färdig för användning vid nanoprägling.

Vid en andra behandling i gasfas placeras stampen i en ugn med vattenfri kvävgasatmosfär vid en temperatur av ca 50-200°C, företrädesvis ca 70-120°C. Ugnen evakueras till ett lågt tryck, lämpligen ca 1-20 kPa, än mer föredraget ca 5-10 kPa. Den exakta kombinationen av temperatur och tryck väljs på sådant sätt att det aktuella andra reagenset med säkerhet föreligger i gasfas. Det andra reagenset förs sedan in i ugnen, exempelvis med hjälp av en spruta, förångas och reagerar under ca 1-10 h med monolagret på stampens yta. Stampen tas ut ur ugnen, får svalna, rengöres sedan på ovan beskrivna sätt och år sedan färdig för användning vid nanoprägling.

Vid den andra behandlingen är stampens yta redan från början täckt med ett monomolekylärt skikt. Reaktion i gasfas är därför vanligen inte någon fördel avseende skiktets homogenitet. Reaktionen i vätskefas är betydligt enklare att utföra och är därför normalt sett att föredra vid den andra behandlingen. Vid mycket små nanostrukturer fordras dock ibland reaktion i gasfas för att ett till-räckligt jämnt skikt ska erhållas efter reaktionen.

Vid en reaktion mellan den ovan beskrivna produkten efter den första behandlingen och de ovan beskrivna föredragna andra reagensen kan således följande resultat

erhållas efter den andra behandlingen då grupperna X1 och X2 reagerat och bildat en grupp Q i form av S-S:

Då den första funktionella gruppen istället för en silangrupp är en fosfatgrupp kan exempelvis utnyttjas ett första reagens i form av merkaptopropylfosforsyra:

15

20

30

35

Efter att detta första reagens fästs på metallskiktet i enlighet med något av ovan beskrivna förfaranden kan det ovan nämnda andra reagenset 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooktantiol sedan utnyttjas i en andra behandling enligt ovan för åstadkommande av följande antividhäftningsskikt på metallskiktets yta (Me i formeln nedan avser en lämplig metall, såsom Ti):

Ett sätt att fästa en fosfatgrupp på en metalloxid beskrivs i "Surface Modifications for optical Biosensor Applications" av Rolf Hofer, Diss. ETH No. 13873, Zürich 2000. Enligt detta sätt behandlas metalloxiden med ett organiskt lösningsmedel som innehåller fosfatgrupper, varvid fosfatgrupperna kemiskt binds till metalloxiden.

Enligt en annan utföringsform bildas ett antividhäftningsskikt genom att man direkt fäster en färdig molekylkedja på stampens yta, exempelvis en molekylkedja som innefattar en grupp som kan binda in till stampens

11.54

yta samt åtminstone en fluorinnehållande grupp. En färdig molekylkedja innebär att antividhäftningsskiktet fästs på stampens yta i ett enda steg, vilket förenklar det praktiska handhavandet. Infästning av en färdig molekylkedja i ett enda steg genomförs på väsentligen samma sätt och under samma förhållanden som ovan beskrivits för den första behandlingen. Det resulterande antividhäftningsskiktet kan vid ett metallskikt av titan exempelvis erhålla nedanstående utseende:

10

25

35

- 15 Ett lämpligt förfarande för framställning av en stamp kan således innefatta följande steg:
  - a) ett stampämne av nickel förses på kånt sått med ett nanomönster på sin yta
- b) stampämnet tvättas på känt sätt med en blandning innehållande 15 vol $^{*}$  NH $_{3}$ , 70 vol $^{*}$  H $_{2}$ O och 15 vol $^{*}$  H $_{2}$ O och torkas sedan
  - c) stampämnet placeras i en vakuum-ugn, varvid förångad metall tillförs och fälls ut på stampämnets yta
  - d) den därmed med ett metallskikt försedda stampen tas ut ur ugnen, varvid metallskiktets yta bringas att oxideras vid kontakt med filtrerad omgivningsluft
  - e) stampens oxiderade metallskikt förses med ett antividhäftningsskikt genom reaktion i ett eller flera steg
- f) stampen tvättas på känt sätt med en serie av organiska lösningsmedel, torkas och är sedan färdig för användning exempelvis vid nanoimprintlitografi eller vid gjutning av föremål med nanomönster.
  - Det finns även andra sätt att framställa en stamp enligt uppfinningen. En möjlighet är att utnyttja en molekyl som istället för ovan nämnda fosfat- och

. . . . .

10

20

25

30

35

;:--:

silangrupper har en karboxylgrupp som första funktionell grupp. Karboxylgruppen binder dock inte in tillräckligt stabilt direkt på ett oxiderat metallskikt av aluminium eller titan. Om metallskiktet däremot ytbehandlas med ett tunt skikt (motsvarande något eller några atomlager) av zirkoniumoxid kommer dock inbindningen av karboxylgrupperna att bli mycket god och ett starkt antividhäftande skikt kan erhållas. Ett skikt av zirkoniumoxid kan även användas för att förstärka bindningen av fosfatgrupper på ett metallskikt av TiO2 eller Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Ett skikt av zirkoniumoxid kan exempelvis fällas ut på metallskiktet av  $TiO_2$  eller  $Al_2O_3$  genom att stampen placeras i en reaktionskammare som evakueras till 0,013 Pa. Destillerad (t-Butyl-O) 4Zr tillföres till reaktorn. Då ett zirkoniumskikt med önskad tjocklek har 15 åstadkommits på stampen tas denna ut ur reaktorn, tvättas och behandlas enligt ovan med ett lämpligt reagens för bildande av ett antividhäftningsskikt.

En annan möjlighet att framställa en stamp enligt uppfinningen är att behandla det oxiderade metallskiktet med en superkritisk vätska som innehåller en lämplig molekyl, tex något av de ovan beskrivna reagensen, i lösning. En sådan vätska år superkritisk CO2. Den låga viskositeten och höga diffusiviteten hos superkritisk CO2 gör att reagenset lätt kan transporteras in i stampens nanostrukturerade reliefmönster och binda in till det oxiderade metallskiktet. Exempelvis kan ett stort överskott av en lämplig molekyl, tex något av de ovan beskrivna reagensen, lösas i en tryckreaktor med superkritisk CO2 vid ett tryck av 7500 psi (500 bar) och en temperatur av 150°C. Stampen placeras i tryckreaktorn under några minuter. Den med ett monomolekylärt skikt försedda stampen tas sedan ut ur tryckreaktorn och tvättas i efterföljande steg med ett lämpligt lösningsmedel.

1. . . .

21

En mindre föredragen möjlighet är att doppa ned stampen med det oxiderade metallskiktet i en lösning som innehåller en lämplig molekyl, tex någon av de ovan beskrivna reagensen. Ett lösningsmedel som kan användas är tetrahydrofuran (THF). Neddoppning i lösningsmedel är dock mycket känsligt för eventuella vattenrester i lösningsmedlet och risken är stor att det antividhäftande skiktet inte får önskad kvalitet. Förbrukningen av reagens blir ofta relativt stor.

10

20

25

30

35

Det antividhäftande skiktet är lämpligen monomolekylärt. I vissa fall kan dock utnyttjas skikt som har en viss polymerisation på skiktets yta.

# 15 Detaljerad beskrivning av ett föredraget utföringsexempel

I fig 1 visas en stamp 1 för användning vid nanoimprintlitografi. Stampen 1 har ett stampämne 2 av nickel. Stampämnet 2 har framställts genom elektroplätering av en strukturerad kiselskiva och därvid erhållit ett antal utskott, i fig 1 schematiskt visat som ett utskott 4 med en höjd HU av ca 200 nm och en bredd BU av ca 200 nm. Ett titanskikt 6 har genom ovan beskrivna förångning i vakuum applicerats på stampämnets 2 yta 8. Titanskiktet 6 har en total tjocklek HT av 10 nm.

Titanskiktet 6 har vid kontakt med filtrerad omgivningsluft bildat en oxidfilm 10, såsom bäst framgår av figur 2. Oxidfilmen 10 har en tjocklek HO av ca 5 nm. Under oxidfilmen 10 föreligger titan fortfarande i metallisk form och bildar därvid ett metalliskt skikt 12 som fasthåller titanskiktet 6 vid stampämnets yta 8.

På oxidfilmens 10 mot omgivningen exponerade yta 14 sitter ett monomolekylärt antividhäftningsskikt, i fig 2 schematiskt visat som 16. Antividhäftningsskiktet 16 har framställts med hjälp av de ovan beskrivna första och andra behandlingarna. Varje molekyl 18 i antividhäftningsskiktet 16 innefattar således en silangrupp 20, som är bunden till oxidfilmen 10, och en

15

30

35

22

fluorinnehållande grupp, i fig 2 schematiskt visad som 22.

Då stampen 1 utnyttjas för att prägla ett mönster i ett DVD-skivämne 24 av polykarbonat värms såväl stampen 1 som DVD-skivämmet 24 upp, varvid utskotten 4 pressas in i det mjuka ämnet 24. De fluorerade alkylgrupperna 22 häftar inte vid ämnet 24 och har därmed den effekten att stampen 1 efter präglingen lätt kan lösgöras från ämnet 24 utan att häfta vid detta.

Det inses att en mängd modifieringar av den ovan beskrivna utföringsformen är möjliga inom ramen för uppfinningen, såsom den definieras av de efterföljande patentkraven. Sålunda kan sättet och formverktyget utnyttjas för framställning av en mängd strukturer i nanoskala. Formverktyget kan antingen pressas in i ett substrat på ett föremål eller användas som en del av en gjutform i vilken ett nanomönstrat föremål skall gjutas. Icke begränsande exempel på sådana föremål år integrerade kretsar, mikroanordningar, magnetiska lagringsmedia och optiska lagringsmedia. Exempel på optiska lagringsmedia 20 är, förutom ovan nämnda CD- och DVD-skivor, även framtida generationers optiska lagringsmedier. Dessa lagringsmedier kan förväntas ha betydligt mindre strukturer ån t ex DVD-skivor och därmed ställa än högre krav på låg vidhäftning mellan formverktyget och 25 exempelvis en polymer på mediets yta.

#### Exempel 1

Vid framställning av en stamp utnyttjades ett stampämne av nickel, som framställts via elektroplätering av en strukturerad kiselskiva för att bilda ett nanostrukturerat mönster lämpligt för framställning av optiska lagringsmedier, såsom CD och DVD-skivor. Mönstret hade utskott med en typisk bredd av 200-600 nm och en höjd av 150 nm. Stampämnet tvättades med en blandning innehållande 15 vol%  $NH_3$ , 70 vol%  $H_2O$  och 15 vol%  $H_2O_2$ . Stampämnet placerades sedan i en ugn som evakuerades till

. . . . . . . . . . .

10

15

20

25

30

35

-:--:

:::::

+46 470 20867

23

ett tryck av 0,013 Pa. Förångad titan tillfördes sedan till ugnen under måtning av titanskiktets tjocklek på stampämnet. När skiktet hade en tjocklek av ca 10 nm avbröts behandlingen och den med ett titanskikt försedda stampen togs ut ur ugnen. Då stampen togs ut i rumsluft skedde en nästan momentan oxidation av titanskiktets yta.

Stampen tvåttades sedan med organisk tvått i tre steg innehållande i tur och ordning trikloretylen, aceton och isopropanol. Varje steg varade i ca 1 minut. Stampen torkades sedan i  $N_2$  atmosfär.

Stampen infördes sedan i en s.k. kallad handskbox, som var fylld med kvävgas vid atmosfårstryck. Halten av såväl syrgas, O<sub>2</sub>, som vattenånga, H<sub>2</sub>O, i handskboxen var under 1 ppm. Stampen placerades i en petriskål, som hade en volym av 20 ml. Petriskålen hade i förvåg passiverats genom en behandling med dimetyl-diklor-silan (10% lösning i diklormetan) för att inte reagera med det tillförda reagenset. Petriskålen placerades på en värmeplatta i handskboxen, varvid en temperatur av 250°C ställdes in på värmeplattan. 10 µl av tridekafluoro-(1,1,2,2)-tetrahydrooktyl-triklorsilan (även kallad F<sub>13</sub>-TCS), injicerades i petriskålen, förångades och fick reagera med stampen under två timmar. Stampen togs sedan ut ur handskboxen, fick svalna, tvättades med hexan i tre på varandra följande bad och torkades sedan med kvåvgas.

Stampen utnyttjades sedan vid nanoimprintlitografi för att överföra ett mönster till en platta som var belagd med ett skikt av en termoplast. Ingen vidhäftning av termoplast vid stampen kunde detekteras.

#### Exempel 2

En stamp försågs med ett titanskikt och tvättades i enlighet med Exempel 1. Den tvättade stampen infördes i en glasreaktor (standard glasreaktor från Schott Gmbh, DE), som i förväg passiverats med hjälp av dimetyldiklorsilan enligt ovan. I en av reaktorns genomföringar

10

+46 470 20867

24

tillfördes ren kvävgas (99,99%) som fick spola igenom reaktorn, varvid kvävgas och kvarvarande luft spolades ut genom en annan genomföring. Efter spolning i 10 minuter evakuerades reaktorn till ett tryck av < 100 Pa för att ytterligare minska mångden syre och vattenånga. Den evakuerade reaktorn upphettades till 250°C på ett värmebad varefter 10  $\mu$ l F<sub>13</sub>-TCS tillfördes genom en injektionsport. Efter 2 h togs stampen ut ur reaktorn och var efter motsvarande tvätt som i exempel 1 färdig att användas.

#### Exempel 3.

En stamp försågs med ett titanskikt och tvättades i enlighet med Exempel 1. Den tvättade stampen placerades i en bågare. Bågaren innehöll ett stort överskott av F13-TCS i vattenfri hexan. Efter 16 timmar vid 50°C togs stampen upp och tvåttades med hexan i tre på varandra följande bad och torkades sedan med kvävgas.

Vid försök med nanoimprintlitografi liknande försöken i exempel l kunde viss deformering av strukturen på plattans termoplast noteras. Detta tyder på att antividhäftningsskiktet inte blev helt jämmt, troligen beroende på viss polymerisering förorsakad av vattenrester.

20

25

#### PATENTKRAV

1. Sätt att framställa ett formverktyg (1), som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål (24) och har ett skikt (16), som är antividhäftande med avseende på föremålet (24), kännetecknat av stegen

att ett stampämne (2) förses med reliefmönster (4) 10 på en yta (8),

att den mönstrade ytan (8) beläggs med ett skikt (6) av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda en mekaniskt stabil oxidfilm,

att skiktet (6) av metall oxideras för bildande av 15 en oxidfilm (10), och

att oxidfilmen (10) påförs åtminstone ett reagens, som innehåller molekylkedjor (18), som var och en har en kopplingsgrupp (20), som binds med kemisk bindning, företrädesvis en kovalent bindning, till oxidfilmen (10),

- varvid molekylkedjorna (18) antingen från början innefattar åtminstone en fluorinnehållande grupp (22) eller i en efterföljande behandling förses med åtminstone en sådan grupp (22).
- Sätt enligt krav 1, vid vilket nämnda metall
   väljs bland titan, zirkonium, niob, tantal och aluminium och blandningar därav.
  - 3. Sått enligt krav 1 eller 2, vid vilket kopplingsgruppen (20) väljs bland silangrupper, fosfatgrupper och karboxylgrupper.
- 30 4. Sätt enligt något av krav 1-3, vid vilket metallen tillförs den mönstrade ytan (8) i förångad form.
  - 5. Sätt enligt något av föregående krav, vid vilket skiktet (6) av metall oxideras genom att bringas i kontakt med en syreinnehållande gas, såsom omgivningsluft, filtrerad omgivningsluft eller en syntetisk syreinnehållande gasblandning.



- 6. Sätt enligt något av krav 1-5, vid vilket den mönstrade ytan (8) beläggs med ett skikt (6) av metall med en tjocklek (HT) av 1-300 nm, företrädesvis 1-100 nm.
- 7. Formverktyg, som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala på ett föremål (24) och har ett 5 skikt (16), som är antividhäftande med avseende på föremålet (24), kännetecknat av att formverktyget (1) innefattar ett stampämne (2), som på sin yta (8) uppvisar ett reliefmönster, och ett skikt (6) av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan 10 bilda en mekaniskt stabil oxidfilm, vilket skikt (6) av metall har applicerats på nåmnda yta (8) och sedan oxiderats för bildande av en mekaniskt stabil oxidfilm (10), varvid det antividhäftande skiktet (16) innefattar molekylkedjor (18), som vardera har åtminstone en 15 kopplingsgrupp (20), som med kemisk bindning, företrädesvis en kovalent bindning, är bunden till oxidfilmen (10), och åtminstone en fluorinnehållande grupp (22).
- 8. Formverktyg enligt krav 7, vid vilken nämnda skikt (6) av metall har en tjocklek (HT) av 1-300 nm, företrädesvis 1-100 nm.
- 9. Formverktyg enligt krav 7 eller 8, vid vilken nämnda stampämne (2) innefattar en metall och/eller 25 kisel.
  - 10. Formverktyg enligt krav 9, vid vilken stampämnet är ett nickelstampämne (2).
  - 11. Formverktyg enligt något av krav 7-10, vid vilken skiktet (6) av metall år ett aluminium-, zirkonium-, tantal-, niob- eller titanskikt.
  - 12. Lagringsmedium, såsom en CD- eller DVD-skiva eller en hårddisk, kännetecknat av att ett formverktyg (1) enligt något av krav 7-11 utnyttjats för utformning av ett reliefmönster på mediet (24).

### SAMMANDRAG

Vid ett sätt att framstålla ett formverktyg (1), som är avsett för utformning av ett reliefmönster i nanoskala 5 på ett föremål (24) och har ett skikt (16), som är antividhäftande med avseende på föremålet (24), förses ett stampämne(2) med reliefmönster (4) på en yta (8). Den mönstrade ytan (8) beläggs med ett skikt (6) av en metall, som har ett stabilt oxidationstal och kan bilda 10 en mekaniskt stabil oxidfilm. Skiktet (6) av metall oxideras för bildande av en oxidfilm (10). Oxidfilmen (10) påförs åtminstone ett reagens, som innehåller molekylkedjor (18), som var och en har en kopplingsgrupp (20), som binds med en kemisk bindning till oxidfilmen 15 (10), varvid molekylkedjorna (18) antingen från början innefattar åtminstone en fluorinnehållande grupp (22) eller i en efterföljande behandling förses med åtminstone en sådan grupp (22).

20

25

30

Publiceringsbild: Fig 2

+46 470 20867





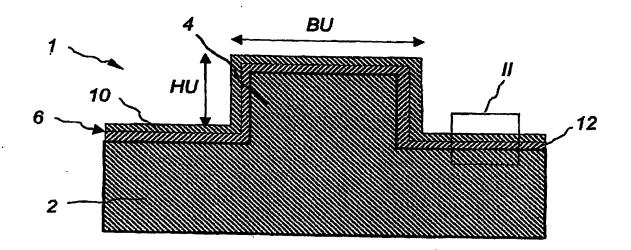


Fig. 1

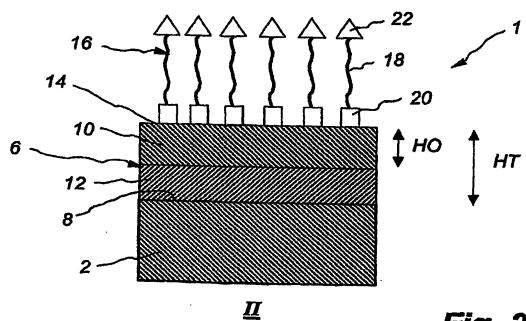


Fig. 2